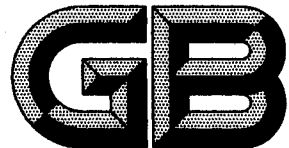


ICS 31.200  
L 55



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15876—1995

---

## 塑料四面引线扁平封装引线框架规范

Specification of leadframes for plastic quad flat package

1995-12-22 发布

1996-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 塑料四面引线扁平封装引线框架规范

GB/T 15876—1995

Specification of leadframes for plastic quad flat package

### 1 主题内容与适用范围

- 1.1 本规范规定了半导体集成电路塑料四面引线扁平封装引线框架(以下简称引线框架)的技术要求及检验规则。
- 1.2 本规范适用于半导体集成电路塑料四面引线扁平封装(PQFP)冲制型引线框架。塑料四面引线扁平封装刻蚀引线框架也可参考使用。

### 2 引用标准

- GB 7092—93 半导体集成电路外形尺寸
- GB/T 14112—93 半导体集成电路塑料双列封装冲制型引线框架规范
- GB/T 14113—93 半导体集成电路封装术语
- SJ/Z 9007—87 计数检查抽样方案和程序

### 3 术语、符号、代号

本规范所用术语、符号和代号按 GB/T 14113 的规定。

### 4 技术要求

#### 4.1 设计

引线框架的外形尺寸应符合 GB 7092 的有关规定,并符合引线框架设计的要求。

##### 4.1.1 引线键合区宽度

4.1.1.1 最小引线端宽度,应按供需双方协议。

4.1.1.2 扁平引线最小键合区,宽为标称引线宽度的 80%,长为 0.635mm。

##### 4.1.2 精压和金属间隙

4.1.2.1 精压深度 最小精压深度为 0.013mm,最大精压深度为材料厚度 30%(仅对冲制型框架)。

4.1.2.2 对于冲制型框架,其图纸上标明的尺寸为精压前尺寸。

4.1.2.3 金属与金属的间隙应受金属间隙的要求限制(引线框架各内引线之间,内引线与芯片粘接区之间),每边最大精压凸出不得超过 0.051mm。金属的间隙,应按供需双方协议。

#### 4.2 引线框架形状和位置公差

4.2.1 内引线扭曲不得超过  $3^{\circ}30'$ ,或每 0.254mm 的引线宽度上最大偏移不得超过 0.015mm。

##### 4.2.2 芯片粘接区斜度和平整度

###### 4.2.2.1 斜度

a. 在未打凹条件下,每 2.54mm 长或宽尺寸最大倾斜 0.025mm。

b. 在打凹状态下,在长或宽每 4.06mm 尺寸最大倾斜 0.051mm。当测试角到角的倾斜时,总共最